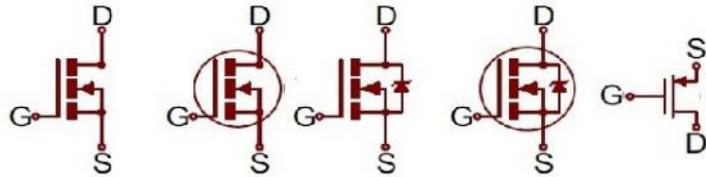


# Test de Mosfets (canal N) avec un multimètre

N-Channel:

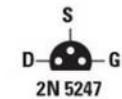
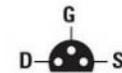
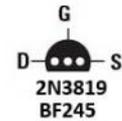
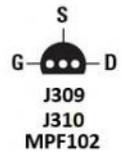
Transconductance = pente  
 Drain = Plaque (plate)  
 Gate = Grille (grid)  
 Source = Cathode



- Mettre le multimètre en "Test Diode"
- Avant les tests, faire un C-C momentané entre G & S pour décharger la capacité de G (le MOS peut être passant par l'accumulation de charges sur la grille)
- Pendant les tests, les pattes du MOS ne doivent RIEN TOUCHER

## I test G-S

Source	Gate		lecture
Noire	Rouge	➔	0.8V à 1.3V
Rouge	Noire	➔	circuit ouvert



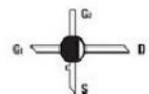
## II test G-D

Gate	Drain		lecture
Rouge	Noire	➔	0.8V à 1.3V
Noire	Rouge	➔	circuit ouvert



## III test D-S

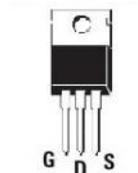
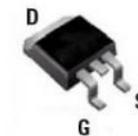
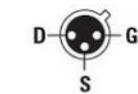
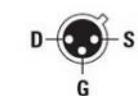
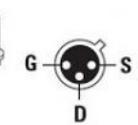
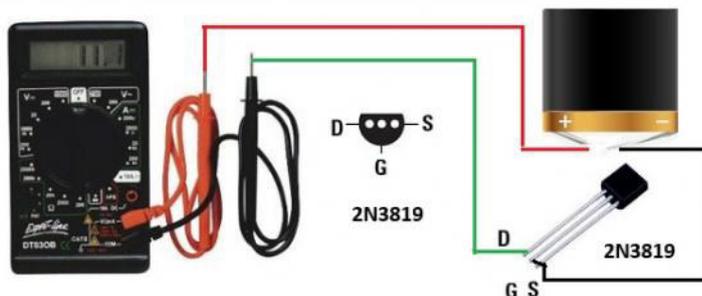
Source	Drain		lecture
Rouge	Noire	➔	0.02V à 0.3V
Noire	Rouge	➔	0.02V à 0.3V



## IV Mesure de l'Idss

Prendre une pile de 4V5 ou une petite alimentation continue de 5à 6V  
 Positionner le contrôleur universel sur la gamme 200mA continu  
 Connecter la gate et la source du transistor au moins de l'alimentation  
 Relier la pointe positive du contrôleur au pôle positif de l'alimentation  
 Enfin relier la pointe négative du contrôleur sur le drain du transistor  
 La valeur de l'Idss apparaît sur l'afficheur.

Inverser les polarités du contrôleur et de l'alimentation pour les FET canal P



Attention : Certains brochages de transistors peuvent variés en fonction du fabricant et de l'année de fabrication !!!